

**Таблица 2. Ограничения дальнейшей миниатюризации [2]**

<b>Характеристики</b>	<b>Предел</b>	<b>Причина ограничения</b>
Толщина окисла	2,3 нм	Туннелирование через окисел
Глубина <i>p-n</i> -переходов	30 нм	Сопротивление областей истока и стока
Легирование канала	$V_i = 0,25 \text{ В}^*$	Подпороговый ток
Мелкие области истока и стока	15 нм	Сопротивление
Длина канала	60 нм	Подпороговый ток
Длина затвора	100 нм	Подпороговый ток

\* $V_i$  — пороговое напряжение.